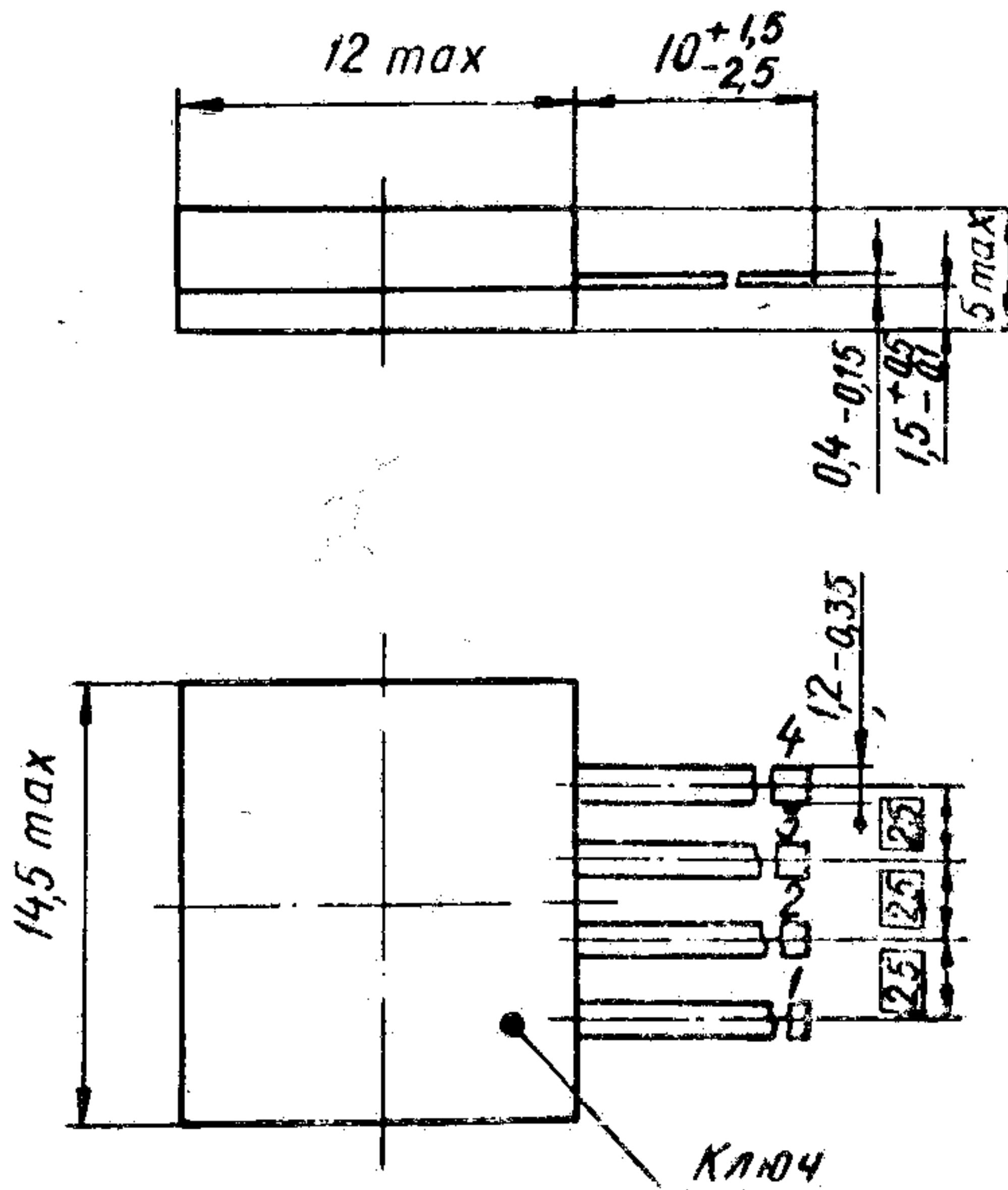


**МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 286**  
**Общие данные**

**ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ**  
**МИКРОСХЕМ 286КТ2, 286КТ2А (КОРПУС 427.4-1)**



Масса не более 2,5 г

Смещение осей выводов от номинального расположения  $\pm 0,1$  мм (допуск зависитый).

Нумерация выводов микросхемы показана условно.

## ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

## Синусоидальная вибрация:

диапазон частот, Гц . . . . . . . . . . . . . . . .	1—5000
амплитуда ускорения, м·с <sup>-2</sup> (g) . . . . .	400 (40)

## Механический удар одиночного действия:

пиковое ударное ускорение,  $\text{м}\cdot\text{с}^{-2}$  (g) . . . . . 15 000 (1500)  
длительность действия ударного ускорения, мс . . . . . 0,1—0,2

## **Механический удар многократного действия:**

пиковое ударное ускорение,  $\text{м}\cdot\text{с}^{-2}$  (g) . . . . . 1500 (150)  
длительность действия ударного ускорения, мс . . . . . 1—5

Линейное ускорение, м·с<sup>-2</sup> (g) . . . . .

Пониженная рабочая температура среды, °С . .

# МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 286

## Общие данные

Повышенная рабочая температура среды, °С . . .	125
Изменение температуры среды, °С . . . . .	от минус 60 до +125
Относительная влажность воздуха при температуре 35°C без конденсации влаги, % . . . . .	98
Атмосферное давление пониженное, Па (мм рт. ст.)	665 (5)
Атмосферное давление повышенное, Па (кгс/см <sup>2</sup> )	до 294 199 (3)

## НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка <sup>О</sup> , ч . . . . .	25 000
Срок сохраняемости <sup>О</sup> , лет . . . . .	25

## УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с требованиями, изложенными ниже.

Допустимое значение статического потенциала 2000 В.

Микросхемы пригодны для монтажа в аппаратуре методом групповой пайки или паяльником. Микросхемы после установки в аппаратуру на теплоотвод должны быть покрыты лаком УР-231 или ЭП-730 не менее чем в три слоя. Микросхемы допускают заливку диэлектрическими компаундами с температурой полимеризации не выше 85°C, обеспечивающими сохранение параметров микросхем в пределах норм после заливки и во всех условиях эксплуатации.

Допускается эксплуатация микросхем при постоянном напряжении не более 350 В между корпусом (теплоотводом) и любым из выводов микросхем, а также между группами выводов 1, 2, 3 и 4, 5, 6 микросхем 286ЕП3, 286ЕП4 и 286ЕП5 (при раздельном включении) при нормальном атмосферном давлении и отсутствии инея с последующим его оттаиванием.

При использовании микросхем необходимо применять заземляющий браслет для устранения паразитного самовозбуждения.

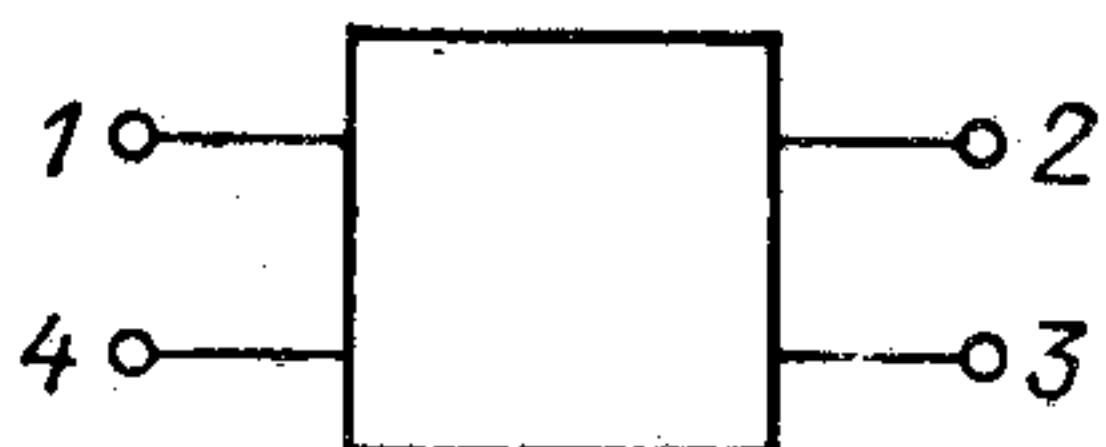
Рекомендуется крепить микросхему к монтажной поверхности с помощью накидного фланца при условии, что температура корпуса, покрытого лаком в три слоя, не должна превышать 85°C.

Для улучшения теплового контакта корпуса микросхемы с теплоотводом рекомендуется использовать пасту КПТ-8. Усилие прижима должно быть 2–10 кгс и равномерно распределено по всей поверхности микросхемы.

Допускается обрезать выводы микросхем после монтажа в аппаратуру на расстоянии не менее 2,5 мм от корпуса, если это не нарушает работоспособности микросхем, с последующим обслуживанием торцов выводов. Допускается однократный изгиб вывода вокруг продольной оси на угол не более 90° на участке длиной не менее 4 мм. При этом усилия изгиба не должны прикладываться к месту заделки вывода в корпус. Допускается при монтаже изгиб выводов в плоскости, перпендикулярной наибольшей стороне сечения выводов, при этом расстояние от корпуса до места изгиба должно быть не менее 1,5 мм, радиус изгиба — не менее 0,8 мм.

О В условиях и режимах, допускаемых ОТУ или ТУ.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА



1 — вход управляющий  
2 — выход аналоговый  
3 — выход аналоговый  
4 — вход аналоговый

В микросхеме 286КТ2А выводы 2 и 3 электрически соединены.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре  $25 \pm 10^{\circ}\text{C}$ )

Ток утечки на выходе, мА, не более . . . . .	10
Сопротивление в открытом состоянии, Ом, не более	0,6
Высокий уровень управляющего напряжения, В, не более . . . . .	3,7
Время включения, мкс, не более . . . . .	0,2
Время выключения, мкс, не более . . . . .	1,5

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ  
И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Постоянное коммутируемое напряжение, В . . .	60
Значение низкого уровня управляющего напряжения, В:	
максимальное . . . . .	0,4
минимальное . . . . .	минус 4,0
Постоянный коммутируемый ток, А . . . . .	3
Импульсный ток управления при высоком уровне управляющего напряжения, А . . . . .	0,5
Импульсный коммутируемый ток, А . . . . .	5
Рассеиваемая мощность с теплоотводом:	
в режиме насыщения, Вт . . . . .	10
без теплоотвода, Вт . . . . .	0,5
Значение средней рассеиваемой мощности с теплоотводом в режиме переключения, Вт . . . . .	7,5
Рассеиваемая мощность в импульсе, Вт . . . . .	500
Частота переключения, кГц . . . . .	100